

厦门华联电子有限公司

Xiamen Hualian Electronics Co., Ltd.

产品规格书 SPECIFICATION

产品名称: 红外发光二极管

产品型号: HIR5B5×F×

电 话: (0592) 6037469 传 真: (0592) 6037471

E-mail: xmhlec@public.xm.fj.cn

Website: www.xmhl.com

地 址: 厦门火炬高技术产业开发区华联电子大厦

邮 编: 361006

● 特点

驱动电流低,辐射强度高。 快速响应时间,可用脉冲驱动。 辐射角度小。

● 用途 近红外遥控系统 探测器用红外光源 光传感器

● 极限参数 (Ta=25℃)

参数名称	符号	额定值	单位
正向电流	I_{FM}	60	mA
正向脉冲电流(1)	I_{FPM}	1	A
反向电压	v_R	5	V
耗散功率	$P_{\mathbf{M}}$	120	mW
工作温度范围	ТОР	-25~+85	${\mathbb C}$
贮存温度范围	T _{st}	-40~+100	$^{\circ}$
焊接温度(2)	T _{sol}	260	${\mathbb C}$

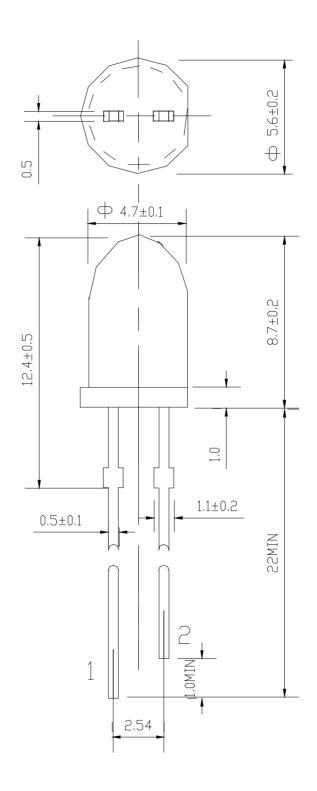
(1) f=1KHz,tp/T≤1% (2) t≤3s,离器件本体4mm以上

● 光电参数 (Ta=25℃)

参数名称	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
正向电压	V _F	$I_F = 50 \text{mA}$	_	1.6	2.0	V
正向脉冲电压	V _{FP}	$I_{FP} = 1 \text{A tp} = 10 \mu \text{ s}$	_	_	3	V
反向电流	IR	$V_R = 5V$	_	_	10	μА
辐射强度	IE	$I_F = 50 \text{mA}$	55		_	mW/sr
峰值发射波长	λP	$I_F = 50 \text{mA}$	_	880	_	nm
光谱半宽度	Δλ	$I_F = 50 \text{mA}$	_	50	_	nm
辐射半强度角	θ 1/2	$I_F = 50 \text{mA}$	25	30	_	度
结电容	Cj	$V_R = 0V f = 1MHz$	_	50	_	pF
开关时间	tr/tf	I _{FP} =100mA f=1KHz,tp/T=1%	_	30/30	_	ns

2003年5月 第 2 页 共 5 页

●外形图



1. 正极

2. 负极

2003年5月 第 3 页 共 5 页